

Galliumarsenidphosphid-Lumineszenzioden *GaAsP Red Light Emitting Diodes*

Anwendung: Rotleuchtende Diode für allgemeine Anzeigezwecke

Application: Red light emitting diode for general indicating purposes

Besondere Merkmale:

- Kunststoffgehäuse
- Axiale Anschlüsse
- Anschlüsse für „wire-wrap“-Verbindungen geeignet
- Höhere Lebensdauernerwartung als Glühlampen
- Erschütterungsunempfindlich
- TTL-kompatibel

Features:

- *Plastic case*
- *Axial terminals*
- *Suitable for wire-wrap connections*
- *Long life compared with filament lamps*
- *Vibration resistant*
- *TTL-compatible*

Vorläufige technische Daten · Preliminary specifications

Abmessungen in mm

Dimensions in mm

Zubehör · Accessories

Montagehülse
Mounting clip

Best.-Nr. 562 136

Haltering
Retainer ring

Best.-Nr. 562 135

Abstrahlwinkel
Angle of half intensity

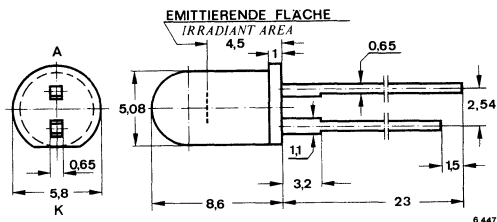
V 135 PL $\alpha = 30^\circ$

V 136 PL $\alpha = 55^\circ$

Spezialgehäuse
Special case

V 135 PL Kunststoff weiß, klar
V 136 PL Kunststoff weiß, matt

Gewicht · Weight
max. 0,4 g



V 135 PL · V 136 PL

Absolute Grenzwerten

Absolute maximum ratings

Sperrspannung Reverse voltage	U_R	5	V
Durchlaßstrom Forward current	I_F	50	mA
Stoßdurchlaßstrom Forward surge current			
$t_p \leq 10 \mu s$	I_{FSM}	1,0	A
Verlustleistung Power dissipation			
$t_{amb} \leq 25^\circ C$	P_V	100	mW
Sperrschichttemperatur Junction temperature	t_j	100	$^\circ C$
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range	t_{stg}	-25...+100	$^\circ C$
Maximal zulässige Löttemperatur Soldering temperature, maximal			
$t \leq 3 s$			
Abstand vom Gehäuse $\geq 2 mm$ Distance to the case	t_{sd}	245	$^\circ C$

Wärmewiderstand

Thermal resistance

	Min.	Typ.	Max.
Sperrschicht-Umgebung Junction ambient			250 $^\circ C/W$

Optische und elektrische Kenngrößen

Optical and electrical characteristics

$t_{amb} = 25^\circ C$

Lichtstärke

Luminous intensity

$I_F = 20 mA$

V 135 PL

V 136 PL

$I_V^*)$ 0,8 1,6 mcd

$I_V^*)$ 1,5 3,0 mcd

Wellenlänge der maximalen Emission

Peak wavelength emission

λ_p 660 nm

Spektrale Halbwertsbreite

Spectral half bandwidth

$\Delta\lambda$ 20 nm

Durchlaßspannung

Forward voltage

$I_F = 20 mA$

$U_F^*)$ 1,6 2,0 V

Durchbruchspannung

Breakdown voltage

$I_R = 100 \mu A$

$U_{(BR)}^*)$ 5 V

Sperrschichtkapazität

Junction capacitance

$U = 0, f = 500 kHz$

C_j 130 pF

*) AQL = 0,65%